





	<p><b>SI2343DS-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI2343DS-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 3.1A SOT-23</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI2343DS-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 91605 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2343DS-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 3.1A SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	91605 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	53 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	540pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI2343DS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2343DS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2343DS-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2343DS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2343DS-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 3.1A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2343DS-T1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 3.1A SOT23</p>	 <p><b>SI2344DS-E3</b> VISHAY SI2344DS-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI2347DS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 5A SOT-23</p>
 <p><b>SI2347DS-T1-E3</b> VISHAY SI2347DS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI2343DS-T1</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 3.1A SOT23</p>	 <p><b>SI2343DS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 3.1A SOT-23</p>	 <p><b>SI2347DS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 5A SOT-23</p>

heiße Teile

Mehr

SI2336DS-T1-GE3	SI2337DS	SI2337DS-T1-E3	SI2337DS-T1-E3	SI2337DS-T1-GE3
SI2337DS-T1-GE3	SI2338DS-T1-E3	SI2338DS-T1-GE3	SI2338DS-T1-GE3	SI2341DS
SI2341DS-T1-E3	SI2341DS-T1-E3	SI2341DS-T1-GE3	SI2341DS-T1-GE3	SI2342DS-T1-E3
SI2342DS-T1-GE3	SI2342DS-T1-GE3	SI2343ADS-T1-GE3	SI2343CDS	SI2343CDS-T1-E3
SI2343CDS-T1-GE3	SI2343CDS-T1-GE3	SI2343DS-T1-E3	SI2343DS-T1-E3	SI2343DS-T1-GE3
SI2344DS-E3	SI2347DS-T1-GE3	SI2347DS-T1-GE3	SI2351DS-T1-E3	SI2351DS-T1-E3
SI2351DS-T1-GE3	SI2351DS-T1-GE3	SI2356DS-T1-GE3	SI2356DS-T1-GE3	SI2365EDS
SI2365EDS-T1-GE3	SI2365EDS-T1-GE3	SI2366DS-T1-E3	SI2366DS-T1-GE	SI2366DS-T1-GE3
SI2366DS-T1-GE3	SI2367DS-T1-E3	SI2367DS-T1-GE3	SI2367DS-T1-GE3	SI2369DS-T1-GE3
SI2369DS-T1-GE3	SI2371EDS-T1-GE3	SI2371EDS-T1-GE3	SI2372DS-T1-E3	SI2372DS-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited